1. Transistor : régime linéaire ou saturation

Ouvrir le fichier « polar 2 sources action sur Rb.asc ».

Astuce : la directive `.model` permet de récupérer un modèle fourni par LTpsice et de le « customiser ». Ici le gain en courant, β , est redéfini à 250

Bonne pratique : pour chaque variante de schéma pensez à sauvegarder sous un autre nom votre fichier (ne jamais travailler sur le même schéma en modifiant en continu !)

*Il est important de comprendre que polariser un transistor c'est fixer i_b à la valeur souhaitée (on choisit comment fonctionne le transistor) . Nous avons à ce stade deux manières d'agir sur i_b : Régler V_e ou R_b . **Il est courant d'agir sur R_b car V_e est imposé (ici nous prendrons $V_e=5V$)***

- 1.1. L'objectif est de voir comment R_b agit sur I_b et par voie de conséquence sur l'état du transistor. Tracer les courbes $250 \times I_b$, I_c , puis rajouter $U_{ce}=V_c$ sur une courbe à part (clic droit>Add plot pane) en fonction de R_b (axe des x). Faire un relevé manuel et indiquez pour chaque portion dans quel état est le transistor

Allures des courbes+interprétation

1.2. Compléter les phrases suivantes

Lorsque le transistor est en **régime linéaire** on constate que est proportionnel Ce rapport de proportionnalité est appelé On peut écrire que $... = \dots\dots\dots$
Le transistor se comporte comme une contrôlée par

Lorsque le transistor est en **régime saturé** on constate que n'augmente plus lorsque on augmente La relation $... = \dots\dots\dots$ est fausse ! et ne sont plus proportionnel. On constate que par contre $..... < \dots\dots\dots$
On constate aussi que la tension $U_{ce} = \dots\dots\dots$.
Le transistor se comporte comme un

1.3. Proposer un modèle équivalent statique quand le transistor est passant et linéaire Quel est la relation entre I_c et I_b .

1.4. Quand le transistor est passant et linéaire quelle est la relation entre U_{ce} et I_c (loi des mailles svp)

1.5. Proposez un modèle équivalent statique lorsque le transistor est **saturé**. Quel est la relation entre I_c et I_b ?

1.6. Quand le transistor est passant et **saturé** que vaut U_{ce} (dépend t'il de I_c dans le cadre de notre modèle parfait)

2. Transistor :etude de la jonction BE

1.7. Ouvrir le fichier « polar 2 sources.asc ». Pour cette étude nous allons fixer R_b et faire varier automatiquement V_e . Simuler. Remplacer V_e sur l'axe des abscisses par V_{be} . Tracer i_b fonction de V_{be} . Comment se comporte la jonction BE du transistor.

1.8. A l'aide clic droit>add Plot pane rajouter 2 courbes : U_{ce} (= V_c) et V_e . Dans quel état est le transistor lorsque $V_e = 0$? Que valent U_{ce} et i_b ?

1.9. Toujours sur la courbe précédant à partir de quel moment la jonction 'commence' à devenir passante. Quel est l'ordre de grandeur à retenir pour V_{be} et pour un transistor passant

1.10. Compléter

Lorsque la jonction BE d'un transistor se comporte comme une

Lorsque la jonction du transistor est bloquée le courant est nul. Le transistor est

Les courants et sont aussi nuls.

Entre C et E je peux remplacer le transistor par un

Lorsque la jonction du transistor est suffisamment passante la tension $U_{be} = \dots\dots\dots$ Environ (elle varie peu). Je peux modéliser cette jonction BE par

Le transistor peut être alors soit en régime..... ou cela dépend de la valeur du courant..... . Pour régler ce courant je peux agir sur mais en général on agit sur

2. Transistor : polarisation en régime saturé

Polariser un transistor c'est fixer le i_b souhaité, donc choisir R_b !

Ouvrir le fichier polar 2 sources sature pwm

2.1. rappeler le modèle équivalent statique du transistor idéalement saturé. Que vaut U_{ce}

2.2. En utilisant le bon modèle équivalent du transistor calculer I_{csat}

2.3. Quel est la seule relation valable entre I_{bsat}

2.4. L'inégalité précédente va être convertie en égalité en appliquant un ratio k appelé coefficient de sur-saturation. De plus afin de pouvoir saturer le transistor dans tous les cas le calcul se fera dans le pire des cas : à savoir β_{min} . Ecrire la relation finale I_{bsat} fonction de I_{csat} , k et β_{min} .

2.5. Calculer I_{bsat} en prenant $k=1.5$ et $\beta_{min}=100$. En déduire R_b grâce à la maille de commande. Simulez afin de vérifiez vos résultats ($\beta=250$ nominal). Visualiser $V_{ce}(t)$ et $V_e(t)$. Indiquez l'état du transistor et vérifiez si votre saturation est correcte.